

УСТАНОВКА МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ И ИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ УРМ 3.279.036

В.А. Парсаев, Н.И. Сушенцов, Д.Е. Шашин

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

МАГНЕТРОННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ, ПОКРЫТИЯ, ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА

INSTALLATION OF MAGNETRON SPUTTERING AND ION ETCHING URM 3.279.036

V.A. Parsaev, N.I. Sushentsov, D.E. Shashin

KEYWORDS

MAGNETRON SPUTTERING, COATINGS, VACUUM INSTALLATION

В данной статье описана модернизированная установка магнетронного распыления и ионного травления УРМ 3.279.036 предназначенная для реализации технологии формирования наноструктурированных пленок различных металлов и их соединений.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Парсаев Владислав Анатольевич – студент магистратуры радиотехнического факультета Поволжского Государственного Технологического Университета,

Сушенцов Николай Иванович - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой конструирования и производства радиоаппаратуры Поволжского Государственного Технологического Университета,

Шашин Дмитрий Евгеньевич кандидат технических наук, доцент Поволжского Государственного Технологического Университета (ORCID: 0000-0002-8222-2824), г. Йошкар-Ола респ. Марий Эл e-mail: vparsayev@mail.ru